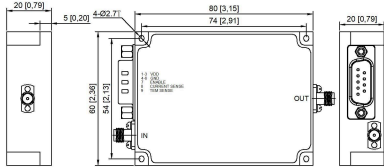


1000–3000 MHz GaN RFパワーアンプ、標準30 W

GaNアンプは1000–3000 MHzで標準飽和出力30 W、標準利得45 dBを備えます。標準平坦度は±1 dB、標準電源は28 VDC、最大32 VDCです。



電気仕様 · Pin=0dBm; +28.0VDC; 25°C; 50Ω

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	1000	-	3000	MHz
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	-	30	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	-	45	-	dB
電力利得平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
入力リターンロス	S11	-	-	-10	dB
30 W 時の高調波	H	-	-12	-	dBc
スプリアス信号 @ PSAT	Spur	-	-50	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	32	VDC
電力付加効率	Eff	-	30	-	%

絶対最大定格 · 出力ポートを開放状態にして使用しないでください。

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm 最大
負荷 VSWR	6:1; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C ±5 °C → 停止 (最大)

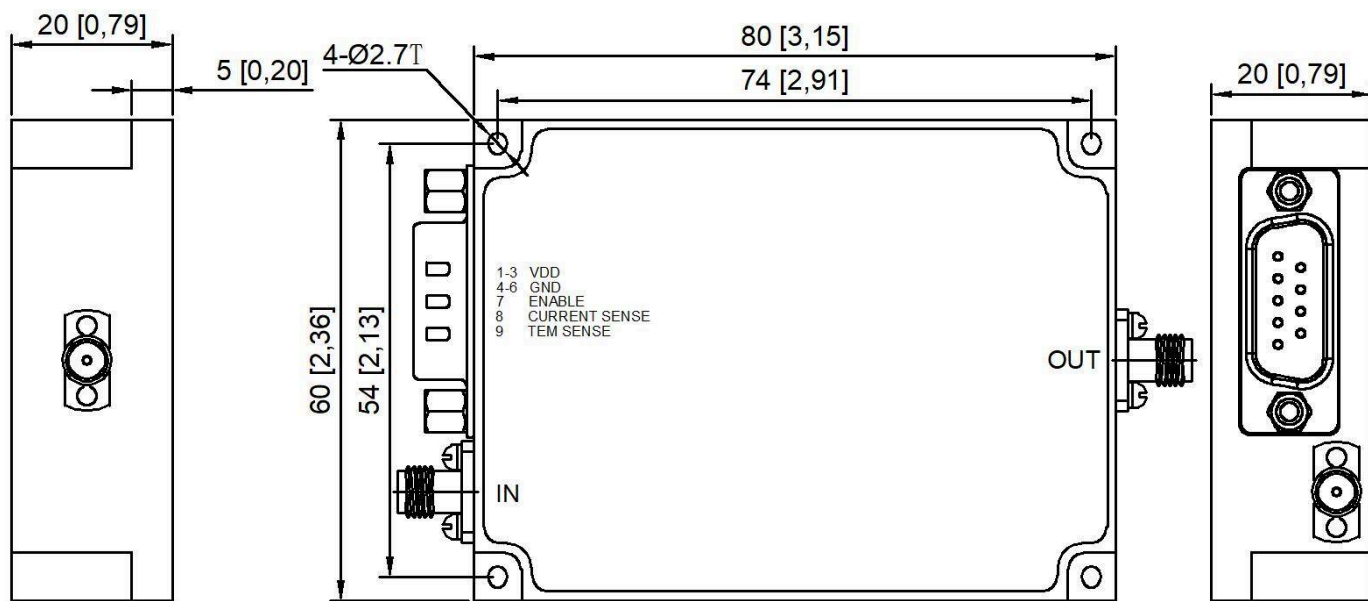
環境仕様 · 設計目標；案件ごとの確認が必要 動作時は電力モジュールをヒートシンクに取り付け、強制空冷を行ってください。モジュールとヒートシンクの間には、サーマルグリースなどの熱伝導材を充填してください。

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
動作温度	-20	-	55	°C	-
保存温度	-40	-	85	°C	保存温度
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%	-

機械仕様・原資料の表ではピン8が温度検出、ピン9が電流検出ですが、元の図面では逆になっています。配線前にピン8/9の機能を確認してください。

項目	値	単位
外形寸法	80 × 60 × 20 [3.15 × 2.36 × 0.78] mm [in]	mm [in]
質量	0.5 [1.1] kg [lb]	kg [lb]
RF 入力コネクタ	J1：SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	J2：SMA, メス	-
DC／制御インターフェース	J3：DB9, オス	-

外形寸法図



寸法の単位はすべて mm [in] です。

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
1-3	1-3 — 電源正極	28VDC～32VDC
4-6	4-6 — グラウンド	グラウンド
7	7 — イネーブル	TTLハイレベル (3.3 V)、内部プルダウン

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。